

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成29年6月22日(2017.6.22)

【公開番号】特開2015-35415(P2015-35415A)

【公開日】平成27年2月19日(2015.2.19)

【年通号数】公開・登録公報2015-011

【出願番号】特願2014-95629(P2014-95629)

【国際特許分類】

H 05 B	33/04	(2006.01)
H 01 L	51/50	(2006.01)
H 05 B	33/12	(2006.01)
H 05 B	33/26	(2006.01)
G 09 F	9/30	(2006.01)

【F I】

H 05 B	33/04	
H 05 B	33/14	A
H 05 B	33/12	E
H 05 B	33/26	Z
H 05 B	33/12	B
G 09 F	9/30	3 3 8
G 09 F	9/30	3 6 5
G 09 F	9/30	3 4 9 B
G 09 F	9/30	3 4 9 Z

【手続補正書】

【提出日】平成29年5月8日(2017.5.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項3】

前記ベース層が前記高分子物質を含む場合、前記高分子物質はポリイミド(polyimide)、ポリカーボネート(polycarbonate)、ポリエチレンテレフタラート(PET:polyethylene terephthalate)、ポリウレタン(polyurethane)、ポリアクリロニトリル(PAN:polyacrylonitrile)、及びポリプロピレン(PP:polypropylene)のうち、いずれか一つを含むことを特徴とする請求項2に記載の表示パネル。

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項6】

前記第1画素電極の光反射率は100%であることを特徴とする請求項1に記載の表示パネル。

【手続補正3】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 8】

前記低温ポリシリコンは 100 度 (Celsius degree) 以下の工程で形成されることを特徴とする請求項 7 に記載の表示パネルの製造方法。